

Кремниевый PIN фотодетекторный чип 6.75×6.75 мм — техническое описание

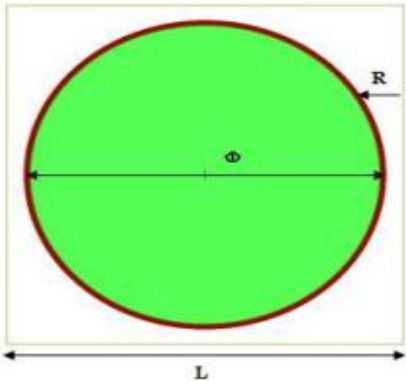
P/N : WS88-01C

Особенности

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод



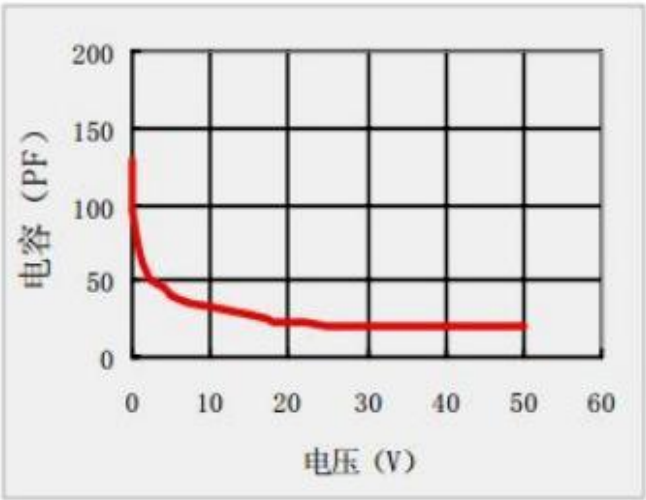
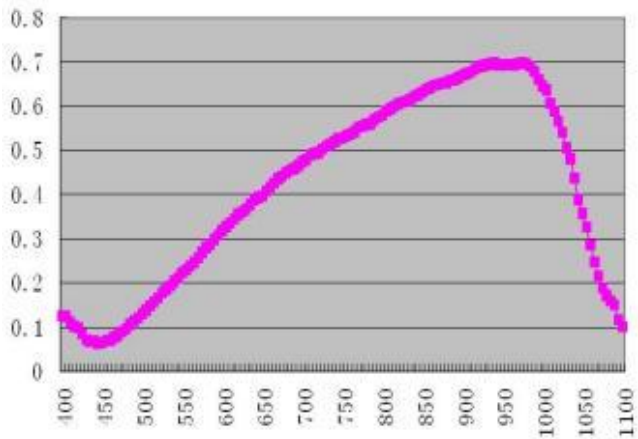
ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	6.0			мм
Толщина кристалла	200±10			мкм
Радиус контактной площадки	110			мкм
Размер	6.75×6.75			мм
Металлизация Р (Ti/Al)	1.2			мкм
Металлизация N (Au)	1.0			мкм
Примечание: PIN-фотодиод имеет планарную структуру с освещением с лицевой стороны; Р-электрод сверху, N-электрод снизу.				

Электрооптические характеристики (при Ta=22±3 °C)

Параметры	Обозн.	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Спектральная чувствительность	λ	-	400 ~ 1100			нм
Активная область	Φ	-	6.0			мм
Чувствительность	Re	λ=900nm, VR=15V	-	0.60	0.65	А/Вт
Время отклика	tr	λ=850nm, VR=15V, RL=50Ω	-	15	30	нс
Прямое напряжение	VF	IF=1mA	-	-	0.70	В
Напряжение обратного смещения	VBR	ID=10μA	120	-	-	В
Темновой ток	ID	VR=15V	-	2.0	10.0	нА
Емкость	CPD	VR=15V, f=1MHz	-	35	50	пФ

Типовые характеристики (при Ta=22±3 °C)



ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Значение	Ед. изм.
Рабочая температура	T _c	-40 ~ +55	°C
Температура хранения	T _{STG}	-50 ~ +100	°C